



半导体学报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 27 卷 第 10 期 2006 年 10 月

目 次

研究快报

- Fabrication of a Silicon-Based Microprobe for Neural Interface Applications Sui Xiaohong, Zhang Ruoxin, Pei Weihua, Lu Lin, and Chen Hongda (1703)
- A Low-Power High-Frequency CMOS Peak Detector Li Xuechu, Gao Qingyun, and Qin Shicai (1707)

研究论文

- A New Method to Investigate InGaAsP Single-Photon Avalanche Diodes Using a Digital Sampling Oscilloscope Liu Wei, Yang Fuhua, and Wu Meng (1711)
- Polar Quasi-Confined Optical Phonon Modes in Wurtzite Quasi-One-Dimensional GaN/Al_xGa_{1-x}N Quantum Well Wires Zhang Li (1717)
- 2D Threshold-Voltage Model for High-*k* Gate-Dielectric MOSFETs Ji Feng, Xu Jingping, Lai P T, Chen Weibing, and Li Yanping (1725)
- A 162GHz Self-Aligned InP/InGaAs Heterojunction Bipolar Transistor Yu Jinyong, Yan Beiping, Su Shubing, Liu Xunchun, Wang Runmei, Xu Anhuai, Qi Ming, and Liu Xinyu (1732)
- A Novel Clock Feedthrough Frequency Compensation for Fast-Settling of Folded-Cascode OTA Ning Ning, Yu Qi, Wang Xiangzhan, Dai Guanghao, Liu Yuan, and Yang Mohua (1737)
- A Current-Mode DC-DC Buck Converter with High Stability and Fast Dynamic Response Chen Dongpo, He Lenian, and Yan Xiaolang (1742)
- Total Dose Radiation-Hard 0.8μm SOI CMOS Transistors and ASIC Xiao Zhiqiang, Hong Genshen, Zhang Bo, and Liu Zhongli (1750)
- 半导体量子点中强耦合激子的性质 李志新 肖景林 (1755)
- ZnO 单晶的缺陷及其对材料性质的影响 魏学成 赵有文 董志远 李晋闯 (1759)
- 低温沉积 ZnO 薄膜的压敏特性及其热处理影响 夏姝贞 陆 慧 王 璞 徐晓峰 杜明贵 (1763)
- 纳米 6H-SiC 薄膜的等离子体化学气相沉积及其紫外发光 于 威 崔双魁 路万兵 王春生 傅广生 (1767)
- 并五苯的溶解及其薄膜性能表征 张旭辉 陶春兰 张福甲 刘一阳 张浩力 (1771)
- PZT 薄膜的制备及其与 MEMS 工艺的兼容性 李俊红 汪承灏 黄 歆 徐 联 (1776)
- 金属 Cr 阻挡层对柔性不锈钢衬底 Cu(In,Ga)Se₂ 太阳能电池性能的影响 张 力 何 青 徐传明 薛玉明 王春婧 施成营 肖建平 李长健 孙 云 (1781)
- 利用 ISSG 退火技术实现沉积二氧化硅薄膜平坦化 陶 凯 孙震海 孙 凌 郭国超 (1785)
- 共振隧穿二极管的压阻特性测试与研究 毛海央 熊继军 张文栋 薛展阳 桑胜波 鲍爱达 (1789)
- 金属单向诱导横向晶化激光修饰多晶硅薄膜晶体管 孟志国 王 文 吴春亚 李 娟 郭海成 熊绍珍 张 芳 (1794)
- X 波段 PHEMT 功率单片放大器 张书敬 杨瑞霞 武继斌 杨克武 (1800)
- Ku 波段 20W GaAs 功率 PHEMT 钟世昌 陈堂胜 (1804)
- 10Gb/s, 0.2μm GaAs PHEMT 跨阻放大器分析与设计 蔡水成 王志功 高建军 朱 恩 (1808)
- 一种新型的低导通电阻折叠硅 SOI LDMOS 段宝兴 张 波 李肇基 (1814)
- 基于漏区边界曲率分析的射频 RESURF LDMOS 耐压与导通电阻优化 池雅庆 郝 跃 冯 辉 方 粮 (1818)
- AlGaN/GaN 异质结构的欧姆接触 杨 燕 王文博 郝 跃 (1823)
- 一种新型半绝缘键合 SOI 结构 谭开洲 冯 建 刘 勇 徐世六 杨谟华 李肇基 张正璠 刘玉奎 何开全 (1828)
- 高散热变 *k* 介质埋层 SOI 高压功率器件 罗小蓉 李肇基 张 波 (1832)
- 宽带低相位噪声锁相环型频率合成器的 CMOS 实现 陈作添 吴 烜 唐守龙 吴建辉 (1838)
- 表面应力测量 SOI 压阻悬臂梁传感器设计与优化 庄志伟 王喆焱 刘理天 (1844)
- 基于半导体光放大器的干涉型器件中不协调性的分析 李亚捷 吴重庆 王拥军 李 赞 季江辉 (1851)
- 铈镱共掺磷酸盐玻璃波导放大器及上转换性质 张 丹 刘 克 张大明 程传辉 张希珍 张海明 潘裕斌 (1857)
- p-GaN/Al_{0.35}Ga_{0.65}N/GaN 应变量子阱肖特基紫外探测器 游 达 许金通 汤英文 何 政 徐运华 龚海梅 (1861)
- 一种基于射频电子标签的超低电压低功耗基带处理器 何 艳 胡建赞 闵 昊 (1866)
- GaAs MMIC 用无源元件的模型 中华军 陈延湖 严北平 杨 威 葛 霁 王显泰 刘新宇 吴德馨 (1872)
- 电热微执行器温度分布节点分析模型 黎仁刚 黄庆安 李伟华 (1880)